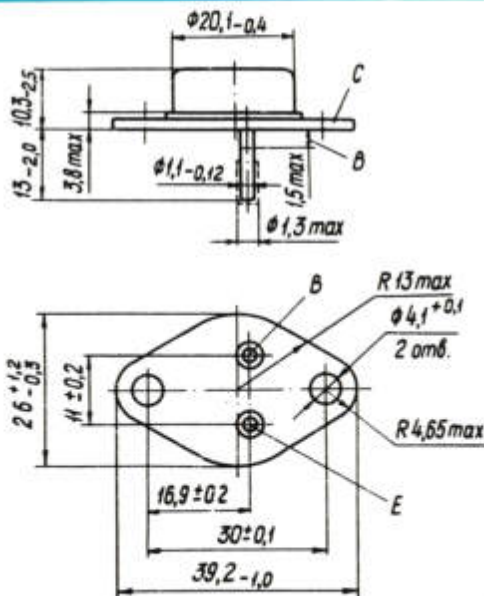


KT847A



БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ HIGH POWER MEDIUM FREQUENCY



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кремниевый меза-планарный n-p-n транзистор KT847A предназначен для работы в схемах вторичных источников питания аппаратуры широкого применения.

Оформление - в металлическом корпусе.
Диапазон допустимых рабочих температур от -45 до +100°С.

GENERAL DESCRIPTION

The KT847A transistors are Silicon mesa-planar n-p-n transistors designed for use in circuits of secondary power supplies of equipment in a wide range of applications.

The devices are encapsulated in metal cases.

Allowable operating temperatures: -45 to +100°С.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ BASIC TECHNICAL CHARACTERISTICS

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ MAXIMUM VALUES OF ALLOWABLE OPERATING CONDITIONS

$U_{CER \max}$ ($R_{BE} < 10 \Omega$)	650 V
$U_{CEM \max}$ ($R_{BE} < 10 \Omega$, $10 \leq t_p \leq 20 \mu s$)	650 V
$U_{EB \max}$	8 V
$I_C \max$	15 A
$I_{CM \max}$ ($t_p \leq 2 ms$)	25 A
$I_B \max$	5 A
$P_C \max^*$ ($t_{case} < 25^\circ C$)	125 W
$t_j \max$	200°С

* При

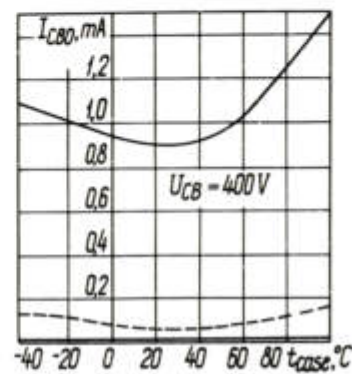
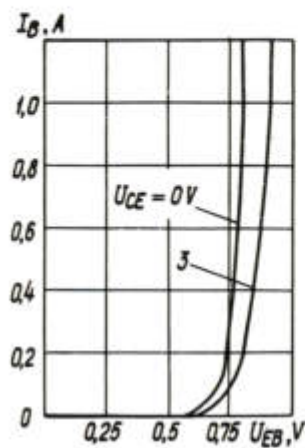
At

$$t_{case} > 25^\circ C - P_C \max = \frac{t_j \max - t_{case}}{R_{thjc}}$$

KT847A

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ELECTRICAL PARAMETERS

Параметры Parameters	Значения Values	Режимы измерений Measuring conditions		
		$U_{CB}; U_{CE}^{\text{нм}}; U_{EB}^{\text{нм}},$ V	$I_C; I_B^{\text{нм}},$ A	f, MHz
I_{CBO}, mA	<5	650		
I_{EBO}, mA	<100	$8^{\text{нм}}$		
h_{21E}	>8	$3^{\text{нм}}$	15	
$ h_{21e} $	$>1,5$	$10^{\text{нм}}$	1,5	10
$U_{CE \text{ sat}}, \text{V}$	$<1,5$		$15; 5^{\text{нм}}$	
C_c, pF	<200	400		
$t_f, \mu\text{s}$	$<1,5$	$200^{\text{нм}}$	15	
$t_s, \mu\text{s}$	<3	$200^{\text{нм}}$	15	

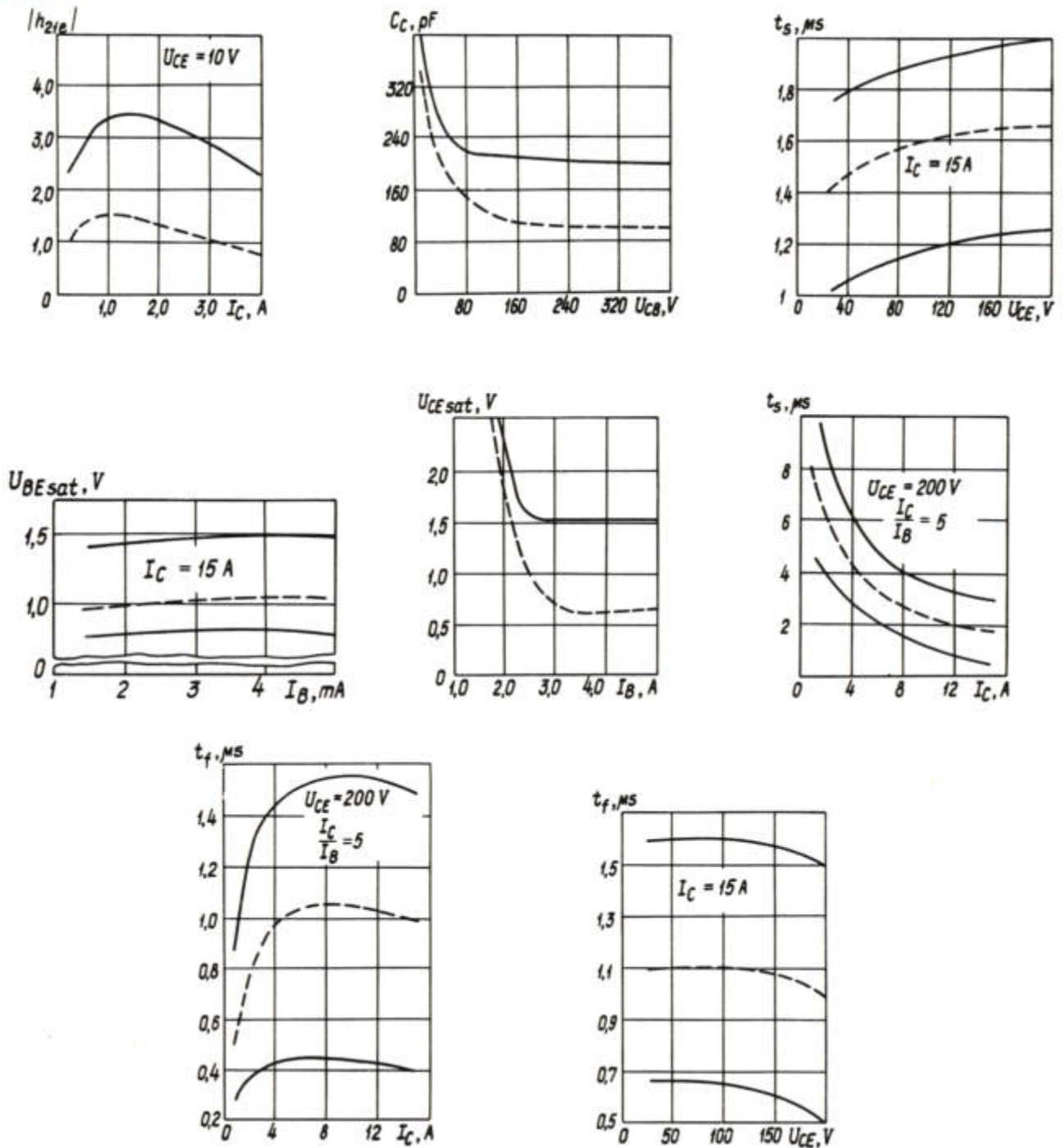


ТИПОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
TYPICAL DEPENDENCE



ГРАНИЦЫ
LIMITS OF **95%** РАЗБРОСА
SPREAD

KT847A



ТИПОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
TYPICAL DEPENDENCE



ГРАНИЦЫ
LIMITS OF **95** / 0 РАЗБРОСА
SPREAD